PAT-NO:

JP363287026A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 63287026 A

TITLE:

METHOD OF MOUNTING SEMICONDUCTOR

INTEGRATED CIRCUIT

ELEMENT

PUBN-DATE:

November 24, 1988

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

SAKUMA, KUNIO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SEIKO EPSON CORP

N/A

APPL-NO: JP62121710

APPL-DATE: May 19, 1987

INT-CL (IPC): H01L021/60

US-CL-CURRENT: 29/827, 438/FOR.372

ABSTRACT:

PURPOSE: To omit bumps on an IC chip, by overlapping a resin film including conductive particles on a conductor pattern, compressing and heating the film with a needle shaped tool, and transferring a conductive projection.

CONSTITUTION: Ni and Au are plated on Cu on a conductor pattern 2 of a circuit board 1. A thermal transfer film 3 made of a polyester resin including Ni particles is overlapped. A heated transfer pin 6 made of Ni alloy is pushed

to the film 3 at a pad position at the end part of the conductor pattern 2.

The resin is melted and a resin projection 5 is formed at a pad part. Then, an

epoxy based insulating bonding agent 7 is applied so as to cover all the resin

projections. The active surface side of an IC chip is made to face the circuit

board and aligned. Pressure is applied and an Al pad 9 and the resin

projections are brought into contact. The device is heated and the bonding

agent is hardened; thus the device is completed.

COPYRIGHT: (C) 1988, JPO&Japio

⑩特許出願公開

[®] 公開特許公報(A) 昭63-287026

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和63年(1988)11月24日

H 01 L 21/60

6918-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

9発明の名称 半導体集積回路素子実装方法

②特 願 昭62-121710

愛出 願 昭62(1987)5月19日

79発明者 佐久間

園 雄

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式

会社内

⑪出 願 人 セイコーエプソン株式

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

砂代 理 人 弁理士 最 上 務 外1名

明相言

1. 発明の名称

半導体築積回路素子実装方法

2. 特許請求の顧困

- (i) 半導体集積回路素子と回路基板との接合時において、次の工程を特徴とする半導体集積回路素子実施方法。
 - (a) 回路基板の専体パターン上に、専電 粒子を含有した機能フィルムを重ね合わせ る工程。
 - (b) 次に、前記世間フィルムの上から、 針状のソールにて、前記回路延振のペッド 部に相当するところの樹脂フィルム位置を 加圧・加熱することにより、回路延振のペッド ッド部に、準電粒子を含有した樹脂塊の突 起を熱転写する工程。
 - (c) 次に、前記樹脂フィルムの非伝写部を除去する工程。

- (d) 次に、前記専体ペターン上に絶縁性、接着剤を塗布する工程。
- (e) 次に、前記回路基板のペッド部突起と、半球体集積回路素子のアルミペッドとを、対向させ位置合わせし、重ね合わせ、 接触させる工程。
- (f) 次に、前紀回路基板と半導体集積回路素子との間の接着剤を硬化させることにより、回路基板の突起と、半導体集積回路 素子のアルミペッドとを接触導通させつつ 固定する工程。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、アルミベッドの半導体集積回路素子 (以下 I C チップと呼ぶ)と回路基板との接合方法に関する。

(従来の技術)

従来の 1 C チップの実装方法は、その一例を第 2 図に示すように、 パンプ 1 1 を有するパンプ付 き 1 C チップ 1 0 を用い、回路基板 1 上に専体ペターン 2 が形成された回路基板に対して、ペンプ 1 1 と基板のペッド 4 が重なり合うように位置合わせを行ない、 次にリフロー炉に通すことにより、ペンプ 1 1 を加熱溶散させて、ペッド 4 と接合させていた。

(発明が解決しようとする問題点)

しかし、前述の従来技術では、ICチップにベンブが必要なため、高価であること、 及び供給メーカーが少ないため入手が困難であるという問題点を有する。

(問題点を解決するための手段)

本発明の半導体集積回路兼子実設方法は、半導体集積回路素子と回路基板との接合時において、 次の工程を特徴とする。

(a) 回路基板の媒体パターン上に、導電

粒子を含有した樹脂フィルムを重ね合わせ る工程。

- (b) 次に、前紀樹脂フィルムの上から、 針状のツールにて、前紀回路基板のパッド 部に相当するところの樹脂フィルム位置を 加圧・加熱することにより、回路基板のパッド部に、厚電粒子を含有した樹脂塊の突 起を熱転写する工程。
- (c) 次に、前紀樹脂フィルムの非転写部 を除去する工程。
- (d) 次に、前記専体パターン上に絶縁性 接着剤を堕布する工程。
- (e) 次に、前紀の回路基板のパッド部突起と、半導体集積回路素子のアルミパッド とを、対向させ位置合わせし、 重ね合わせ、後触させる工程。
- (f) 次に、前紀回路基板と半導体集積回路素子との間の接割剤を硬化させることにより、回路基板の突起と、半導体集積回路 装子のアルミベッドとを接触構通させつつ

固定する工程。

(作用)

本発明の上記の工程によれば、 回路基板側に導 電性の突起を容易に形成できるため、 I C チップ としては、 メンプを必要としなくなる。

(実施例)

第 1 図は本発明の実施例における工程図であったまず第 1 図(a)に示すように、回路基板 1 上に形成された準体 4 ターン2 の上に、 4 ルム 3 を並ね合わせる。この熱 5 写フィルム 3 は子を立ね合わせる。この熱 5 写フィルム 3 は子を立ね合わせる。この熱 5 写フィルム 3 は子を放かる。また、回路基板 1 はガラスエボキシ基材で構成され、 4 体 4 リーン2 は 銅上へニッケル及び金メッキを施している。

次に、第1図(b)に示すように、加熱した転写ピン8を、球体ペターン2の増部の球体ペッド路4上に位置した熱転写フィルム3に押しつけ、その熱により、熱転写フィルム3の樹脂を溶解させ、坂体ペッド部へ付着させることにより、樹脂

実起 5 を 遊 体 パット が 部 へ形 成 す る。 C の 転写 ピンローッケル 合 金 製 で あ り 、 先 婚 の 直 径 が 約 1 0 0 に 加 熱 さ れ て お り 、 私 任 特 時間 は 約 0 。 3 P e c に 加 熱 さ れ て お り 、 熱 任 特 時間 は 約 0 。 3 P e c に か り 、 加 圧 力 は 約 5 0 g で あ む 。 ま た 位 置 か で と と の は は 、 X Y Z 軸 方 向 の 設 定 し た 位 置 か 作 に よ り 、 1 C チップ の ア ル ミ パット 位置 に 対 に な 数 の 遊 体 パット 部 へ 、 樹 脂 突起 を 形 成 で き る。

次に、第1図(c)に示すように、熱転写フィルム3の非転写部を分配移動させる。

次に、第1回(d)に示すように、全ての供助 実和部をおおうように、絶縁性接着刺7を堕布する。この接着剤7はエポキン系である。

次に、第1図(e)に示すように、1 C チップ8の能動面側を回路基板に対向させ、1 C チップ8のアルミベッド 9 と、樹脂突起 5 とを位置合わせし、1 C チップの裏面を加圧することにより、アルミベッド 9 と樹脂突起 5 とを互いに接触させる。この時の加圧力は約5 k g である。

次に第1図(f)に示すように、ICチャブを加圧しつつ、ICチャブと回路基板の間に存在する後着剤を加熱により硬化させることにより、ICチャブ8のアルミペッド9と、回路基板の樹脂突起5とが快触した状態にて固定され、電気的に遊過させることが出来、後合が完了する。この時の加熱温度は150~250℃である。

(発明の効果)

以上に述べたように、本発明によれば、、転写ととを用いて、、 専電粒子を含んだ樹脂フィルのち、回路基板の導体ペッド部に、 専電性樹脂を急を熱転写し、次にその突起と「Cチップのアルミペッドとを接触させた状態にて絶縁性接着剤にていまして、電気的接続をとったことにより、「Cチップに高価でかつ入手困難なペンプを必要としないという非常な効果を有する。

4. 図面の簡単な説明

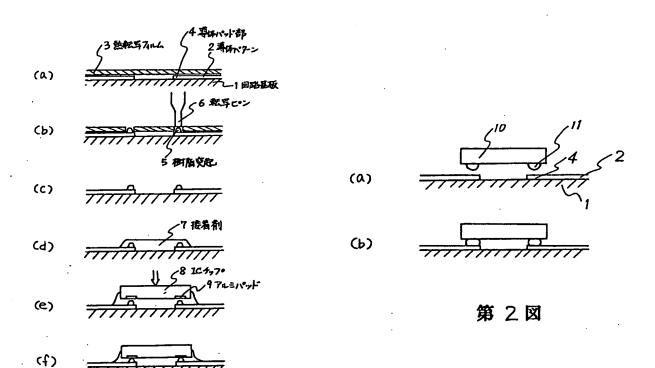
第2図(a)(b)は従来の半導体集積回路素子実装方法を示す主要工程図。

- 1 … 回路基板
- 2 … 単体 ペターン
- 3…熱転写フィルム
- 4… 媒体ペッド部
- 5 … 松脂突起
- 8…仮写ピン
- 7 … 接着剂
- 8 ··· I C + + 7
- 9…アルミペッド
- 10… バンプ付き 1 C チップ
- 11…ペンプ

DI H

出願人 セイコーエブソン株式会社 代理人 弁理士 最 上 務 他 1.8





第 1 図